

S1VB□**800V 1A****特長**

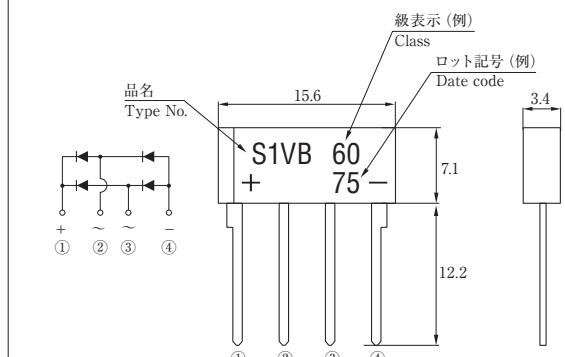
- ・小型 SIP パッケージ

Feature

- ・Small-SIP

■外観図 OUTLINE

Package : 1V

Unit : mm
Weight : 1.1g(typ.)

外形図については新電元 Web サイト又は〈半導体製品一覧表〉をご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of outline dimensions, refer to our web site or the Semiconductor Short Form Catalog. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection."

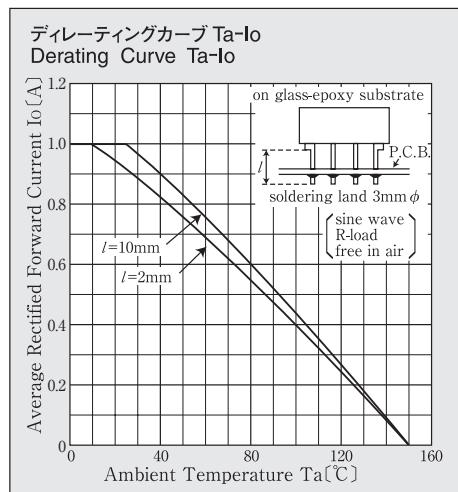
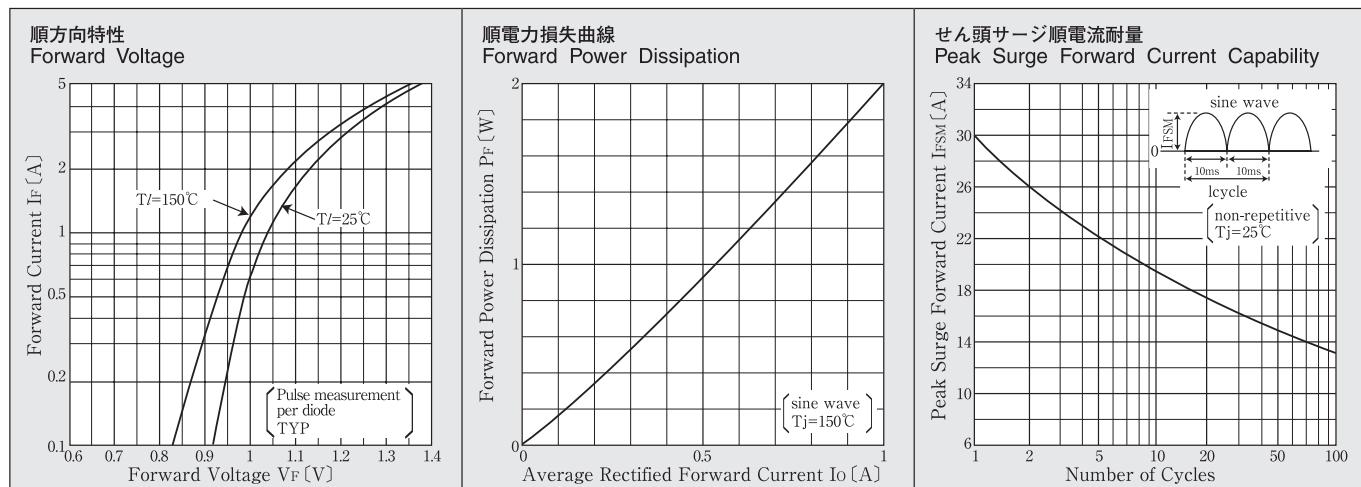
■定格表 RATINGS**●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 $Tl = 25^\circ\text{C}$ / unless otherwise specified)**

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	S1VB60	S1VB80	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	Tstg			-40~150		°C
接合部温度 Operation Junction Temperature	T _j			150		°C
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V _{RM}			600	800	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	I _O	50Hz 正弦波, 抵抗負荷, プリント基板実装, T _a =25°C 50Hz sine wave, Resistance load, On glass-epoxy substrate, T _a =25°C		1		A
せん頭サーボ順電流 Peak Surge Forward Current	I _{FSM}	50Hz 正弦波, 非繰り返し 1 サイクルせん頭値, T _j =25°C 50Hz sine wave, Non-repetitive 1cycle peak value, T _j =25°C		30		A
電流二乗時間積 Current Squared Time	I ² t	1ms≤t<10ms, T _j =25°C, 1 素子当たりの規格値 per diode		4.5		A ² s

●電気的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 $Tl = 25^\circ\text{C}$ / unless otherwise specified)

順電圧 Forward Voltage	V _F	I _F =0.5A, パルス測定, 1 素子当たりの規格値 Pulse measurement, per diode	MAX 1.05	V
逆電流 Reverse Current	I _R	V _R =V _{RM} , パルス測定, 1 素子当たりの規格値 Pulse measurement, per diode	MAX 10	μA
熱抵抗 Thermal Resistance	θ _{jl}	接合部・リード間 Junction to Lead	MAX 16	°C/W
	θ _{ja}	接合部・周囲間 Junction to Ambient	MAX 62	

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



- * Sine wave は 50Hz で測定しています。
- * 50Hz sine wave is used for measurements.
- * 半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っております。Typical は統計的な実力を表しています。
- * Semiconductor products generally have characteristic variation. Typical is a statistical average of the device's ability.